

アプリケーション

カスタマイズされた SOI ソリューションは以下のよう
な分野でつかわれております。:

- 高度なプレッシャーセンサー
- 加速度計
- ジャイロ스코ープ
- マイクロ流体力学/フローセンサー
- RF MEMS
- 光マイクロマシーン/光 MEMS
- 光エレクトロニクス
- スマートパワー
- 最先端 Analog IC 技術
- マイクロフォン
- 高級腕時計

最終市場:

- テレコミュニケーション
- 医療
- 自動車
- コンシューマー
- 楽器

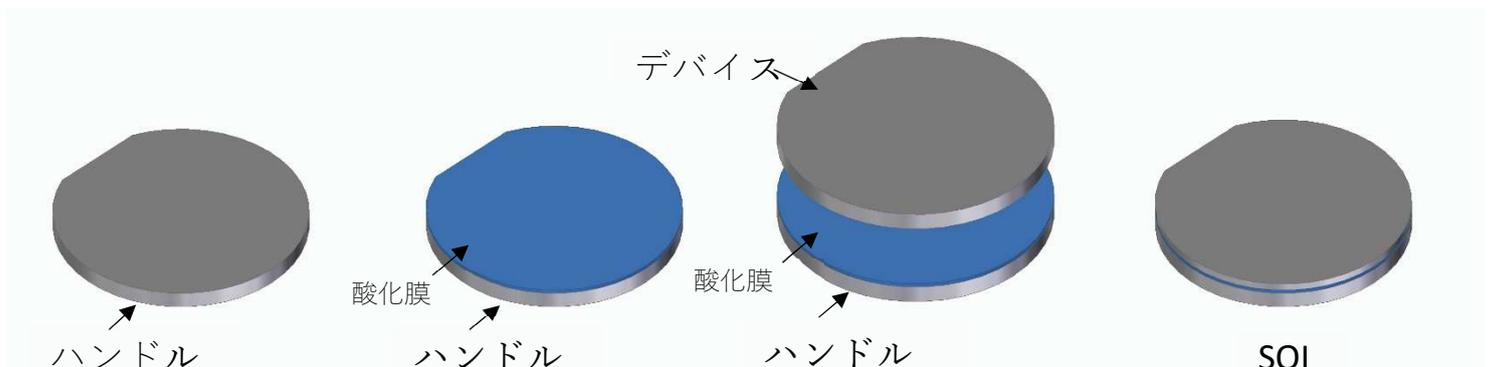
アイスモス・テクノロジーは IC や MEMS 応用など広い範囲に適用される 100–200 mm の厚膜 SOI (Silicon-On-Insulator) ウエハーのリーディングサプライヤーです。20 年以上の SOI 製造の経験で、広い分野の市場に対応できる仕様のスペックのウエハーをご提供いたします。

様々な SOI 基板の経験を通して、高いスキルをもつアプリケーションエンジニアチームが、要求事項に応じてパラメーターのお見積りの選択をお手伝いいたし、完璧なカスタム SOI のソリューションとして提供いたします

6 シグマの統計学的管理手法に基づくプロセス管理で常に継続的改善を進めながら、アイスモスは世界クラスの製品品質を提供いたします。十分に競争できるコストと柔軟な対応で、アイスモスは御社の SOI の理想的なパートナーであり続けます。



SOI ウエハー <1.5mm エッジテラス構造



SOI Specification

パラメーター	仕様 範囲	
ウェハー直径	100, 125, 150 mm	200 mm
ハンドル層 仕様		
ハンドル層 厚さ	200-1100 μm	450-1100 μm
ハンドル層 厚さ 公差範囲	$\pm 5 \mu\text{m}$	
重ね 厚さ 範囲	280-1150 μm	
ドーパントタイプ	N または P	
ドーピング	N type: Phos, Red Phos, Sb & As P type: Boron	
抵抗率	$\leq 0.001 - \geq 10000 \Omega\text{-cm}$	
シリコン成長方法	CZ, MCZ or FZ	
結晶方位	$\langle 100 \rangle$, $\langle 111 \rangle$ or $\langle 110 \rangle$	
裏面処理	ラップ仕上げ/エッチングまたはポリッシュ磨きによる	
埋め込み酸化膜 仕様		
熱酸化膜、埋め込み酸化膜厚さ	0.2 - 4.0 μm ハンドル、デバイスまたは両方に成長	
デバイス層の仕様		
デバイス層膜厚	$\geq 1.5 \mu\text{m}$	$\geq 5 \mu\text{m}$
デバイス 厚さ 公差範囲	$\pm 0.5 \mu\text{m}$	$\pm 0.8 \mu\text{m}$
ドーパントタイプ	N or P	
ドーピング	N type: Phos, Red Phos, Sb & As P type: Boron	
抵抗率	$\leq 0.001 - \geq 10000 \Omega\text{-cm}$	
シリコン成長方法	CZ, MCZ or FZ	
結晶方位	$\langle 100 \rangle$, $\langle 111 \rangle$ or $\langle 110 \rangle$	
埋め込み層のインプラ	N type または P type	

上記は標準の仕様ですが、特定の仕様のソリューションについて、喜んでお客様のご要望を検討させていただきます。
他のスペックなどお問合せなどがありましたら、セールスチームへコンタクトして下さい: sales@icemostech.com